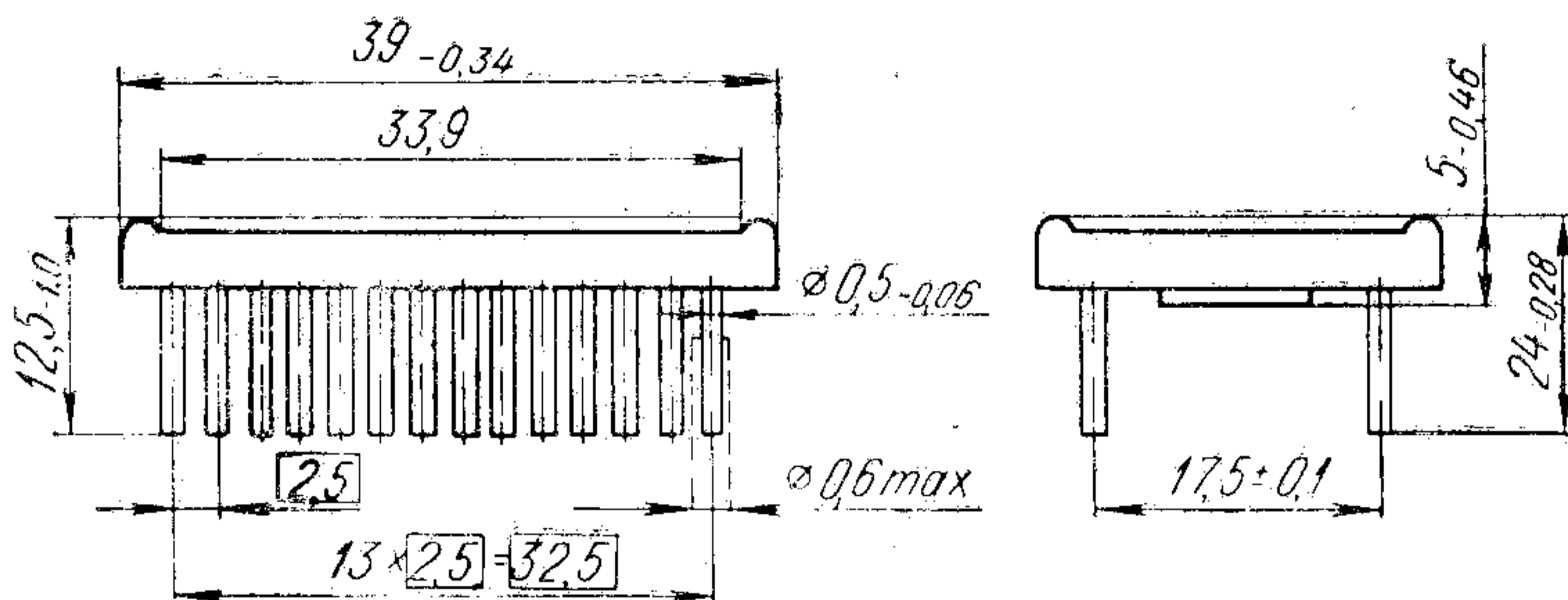


МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 301

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса не более 10 г

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц

для микросхем 301НР1—301НР6	от 1 до 3000
» » 301НР7—301НР12	от 1 до 5000

амплитуда ускорения, м·с⁻² (g)

для микросхем 301НР1—301НР6	150 (15)
» » 301НР7—301НР12	400 (40)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, м·с⁻² (g)

для микросхем 301НР1—301НР6	5000 (500)
» » 301НР7—301НР12	15 000 (1500)

длительность действия ударного ускорения, мс

от 0,1 до 2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, м·с⁻² (g)

для микросхем 301НР1—301НР6	750 (75)
» » 301НР7—301НР12	1500 (150)

длительность действия ударного ускорения, мс

от 1 до 5

Линейное ускорение, м·с⁻² (g)

1500 (150)

Повышенная температура среды, °С:

для микросхем 301НР1—301НР6	85
» » 301НР7—301НР12	100

Пониженная температура среды, °С

минус 60

Изменения температуры среды, °С:

для микросхем 301НР1—301НР6	от минус 60 до +85
» » 301НР7—301НР12	от минус 60 до +100

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 301

Общие данные

Атмосферное пониженное давление, мм рт. ст. (Па):	
для микросхем 301НР1—301НР6	5 (665)
» » 301НР7—301НР12	10 ⁻⁶
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка [○] , ч	25 000
Срок сохраняемости [○] , лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Допускается кратковременная двухкратная перегрузка по напряжению на входах с сохранением характеристик во время и после снятия перегрузки. Длительность воздействия перегрузки для микросхем 301НР1—301НР6 — 2 мин, для микросхем 301НР7—301НР12 — 5 мин, количество перегрузок — не более 5 в течение 1 ч, интервал между перегрузками — не менее 8—10 мин.

Выводы микросхем формовке не подлежат. В технически обоснованных случаях допускается удалять нерабочие выводы микросхем и излишки рабочих выводов после пайки любым способом, исключая нарушение запрессовки вывода в основании корпуса и не приводящим к ухудшению электрических параметров микросхем.

[○] В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25°C)

Входное напряжение, В, не более:	
на выводах 2, 3, 36, 5, 24, 7, 22, 9, 20, 11, 18	30
» » 16—17, 13—15, 12—18	15
Сопротивление резисторов R20, R21, R22, кОм:	
при ТКС = $\pm 100 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$	от 12,255 до 32,745
» ТКС = $\pm 200 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$	от 27,51 до 32,49
Относительная погрешность коэффициентов деления, %, не более	$\pm 0,016$
Сопротивление изоляции (испытательное напряжение прикладывается между экраном и закороченными выводами), МОм, не менее	100
Время установления переходного процесса, мкс, не более	0,7

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рассеиваемая мощность в корпусе, мВт	130
Максимальное входное напряжение, В	90